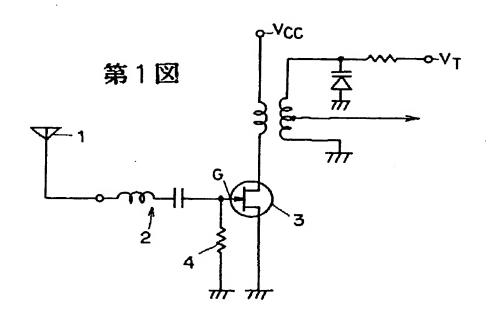
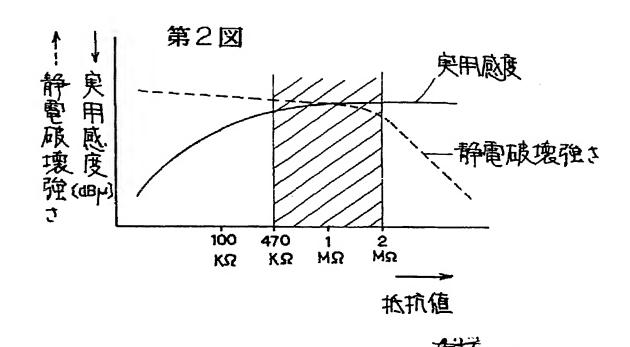
THIS PAGE BLANK (USPTO)





実用新案登録出願人 アルプス電気株式会社

A HEF 44

小加工

at- the sk

Period to the Spires

このために、LWバンドAMチューナにあっては、実用感度および電界効果トランジスタ3の静電破壊強さの双方を実用的に満足するには、バイアス抵抗4の値が470ΚΩ~2MΩの間に設定されれば良い。特に、好ましい値としては1MΩである。

(考案の効果)

以上説明したように、本考案のLWバンドAMチューナのRF増幅回路によれば、LWバンドのAM放送に対して十分な実用感度が得られ、しかも電界効果トランジスタの静電破壊強さも実用的に十分に確保できるという優れた効果を奏する。

第1図は、本考案のしWバンドAMチューナのRF増幅回路の一実施例の回路図であり、第2図は、バイアス抵抗の値を変化させたときのしWバンドに対する実用感度および電界効果トランジスタの静電破壊強さの特性図である。

1:アンテナ、3:電界効果トランジスタ、

4:バイアス抵抗、G:ゲート。



4311 448

化させたときのLWバンドに対する実用感度および電界効果トランジスタの静電破壊強さの特性図である。

第1図において、アンテナ1からのアンテナ入力信号はアンテナ入力回路2を介して非同調で電界効果トランジスタ3のゲート G に与えられ、この電界効果トランジスタ3で増幅されて後段に出力される。そして、電界効果トランジスタ3のゲートと接地間にバイアス抵抗4が介装されている。

かかる R F 増幅回路において、 L W バンドの A M 放送をアンテナ入力信号として、 バイアス 抵抗 4 の 値 号と と 第 2 図に実線で示すごとく 増加 砂 値 パイアス 抵抗 4 の 値 の 上昇 と と に 増加 し、 4 7 0 K Ω 程度から実用 感度の イアス 抵抗 4 の 値 の 上昇 が ス な る ほど、 第 2 図に 破壊 強 で さ は な の 値 界 外 果 ト ランシス タ 3 の 静電 破壊 強 う に 電 界 効 果 ト ランシス タ 3 の 静電 破壊 強 る ぐ な る 。



(問題点を解決するため手段)

かかる目的を達成するために、本考案のLWバンドAMチューナのRF増幅回路は、アンテナ人力信号を電界効果トランジスタのゲートに与えて増幅するRF増幅回路であって、前記電界効果トランジスタのゲートと接地間に介装するバイアス抵抗の値を470KQ~2MQの間に設定されて構成されている。

(作用)

RF増幅回路に含まれる電界効果トランジスタのゲートと接地間に介装されるバイアス抵抗の値を470KQ~2MQの間に設定したので、LWバンドのAM放送の実用感度を向上でき、しかも電界効果トランジスタの静電破壊に対して充分な強度を有する。

(実施例の説明)

以下、本考案の実施例につき第1図および第2図を参照して説明する。第1図は、本考案のLWバンドAMチューナのRF増幅回路の一実施例の回路図であり、第2図は、バイアス抵抗の値を変



ートと接地間に介装されるバイアス抵抗の値はほとんど 1 0 0 K Ω 程度に設定されている。

(考案が解決しようとする問題点)

上記バイアス抵抗の値を100KΩに設定した ものは、日本国内のAM放送帯域の526、5K Hz~1606.5KHzおよび米国内のAM放 送帯域の525KHz~1705KHzに対して 実用感度が優れている。

ところで、欧州では上記日本および米国のAM 放送帯域より放送周波数の低いLWバンドとして 1 4 8 . 5 K H z ~ 2 8 3 . 5 K H z が送信され ている。そして、このLWバンドに対して、従来 のAMチューナのRF増幅回路でバイアス抵抗を 1 0 0 K Q にしたものは、十分な実用感度が得ら れないという問題点があった。

本考案の目的は、上記従来のAMチューナのRF増幅回路の問題点を解決するためになされたもので、LWバンドの実用感度を向上させるようにしたLWバンドAMチューナのRF増幅回路を提供することにある。

133

1、考案の名称

LWバンドAMチューナのRF増幅回路

2、実用新案登録請求の範囲

アンテナ入力信号を電界効果トランジスタのゲートに与えて増幅するRF増幅回路であって、前記電界効果トランジスタのゲートと接地間に介装するバイアス抵抗の値を470KQ~2MQの間に設定することを特徴としたLWバンドAMチューナのRF増幅回路。

3、考案の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本考案は、LWバンドAMチューナの感度を向上させるように改善したLWバンドAMチューナのRF増幅回路に関するものである。

(従来の技術)

従来より、AMチューナのRF増幅回路として、アンテナ入力信号を非同調で電界効果トランジスタのゲートに与えて増幅する回路が用いられている。そして、この電界効果トランジスタのゲ



444

⑲ 日本 萬特 許 庁 (j P)

⑪実用新案出顧公開

⁽³⁾ 公開実用新案公報 (U)

昭63-35337

@Int.Cl.4

۲.

識別記号

厅内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)3月7日

H 04 B 1/18 C-7251-5K G-7251-5K 6628-5J

審査請求 未請求 (全 頁)

図考案の名称

// H 03 F

LWバンドAMチューナのRF増幅回路

②実 顧 昭61-129012

弘明

❷Ⅲ 曆 昭61(1986)8月25日

砂考 案 者 佐々木

3/16

東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルプス電気株式会社

内

切出 顧 人 アルプス電気株式会社

東京都大田区雪谷大塚町1番7号

砂代 理 人 弁理士 森山 哲夫

THIS PAGE BLAGE

Utility Design No. S63-35337

RF Amplification Circuit of LW band AM Tuner

- 1. Title of the Utility Design
- 5 RF Amplification Circuit of LW Band AM Tuner
 - 2. What is claimed is

A RF amplification circuit of an LW band AM tuner, for supplying an antenna input signal to a gate of an field-effect transistor and amplifying the signal, in which a value of a bias resistor inserted between the gate of the field-effect transistor and ground is set between $470 \mathrm{K}\Omega$ and $2 \mathrm{M}\Omega$.